



2020年12月10日

**A1N、GaN などの紫外発光デバイス用および先端デバイス用 MOCVD が
公益社団法人日本表面真空学会の産業賞を受賞**

大陽日酸株式会社が開発した A1N、GaN などの紫外発光デバイス用および先端デバイス用 MOCVD が公益社団法人日本表面真空学会の「令和 2 年度産業賞」を受賞しましたのでお知らせいたします。

同賞は公益社団法人日本表面真空学会が、表面・真空科学関連産業の進歩発展に大きく貢献したと認められる製品、技術ノウハウまたはそれに類する成果をあげた同会会員に対して年一回授賞するものです。

<受賞した MOCVD 装置について>

当社は 1983 年より MOCVD 法（有機金属化学気相成長法）を用いた化合物半導体製造装置の開発に取り組んでおり、これまでに国内外のメーカー、研究機関などに 500 台以上の MOCVD 装置の納入実績があります。

当社は、紫外発光デバイス向けとして、A1N の成膜に適した MOCVD 装置 SR4000HT を 2015 年に開発しております。本装置は 1300℃以上の高温での成膜を可能にした装置であり、本装置を使用してプロセス開発を行い、2019 年には、発光効率の高い UV-LED エピウェハを生産可能であることを実証しました。

また、2012 年に開発した 8 インチ基板 6 枚を処理可能な大型量産装置 UR26K により、2018 年には、8 インチ Si 基板上 GaN 電子デバイス（GaN-HEMT）の高性能化と量産が可能であることを実証しました。本装置の開発にあたっては、結晶成長における膜厚均一性の確保、運転時間短縮による生産性の向上、反応炉内部品の洗浄技術の 3 つの観点に考慮しました。

今後、更なる生産性の向上のための量産対応および自動搬送技術開発に取り組み、新技術、新商品の普及を図ることで、環境負荷低減技術の普及および産業界における省エネルギー化に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ
大陽日酸株式会社
東京都品川区小山 1-3-26
管理本部広報部
TEL: 03-5788-8015